

DHA[®]

QJ/DHA 09.32-2018

LD830

N-沟道 MOSFET 功率晶体管

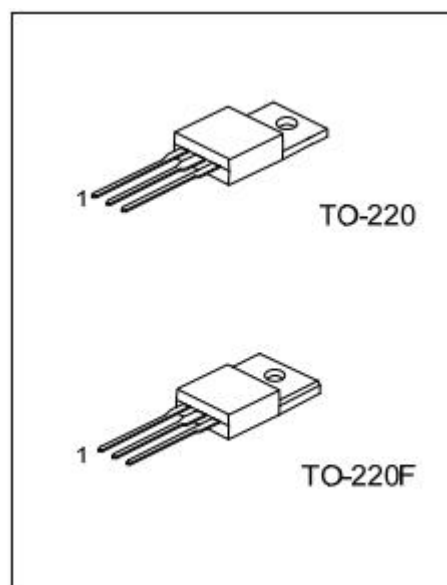
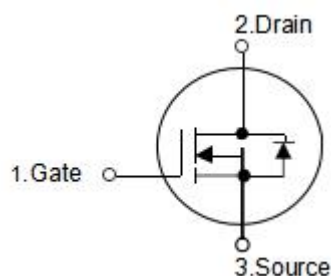
描述

N 通道 MOSFET 采用塑料 TO220 封装。符合 RoHS。

用途

它们适用于离线开关模式电源，电视和计算机监视器电源。DC-DC 转换器，电机控制电路和通用开关应用。

等效电路图



电参数 (Tamb = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV _{DSS}	漏极-源极 击穿电压	V	500	-	-	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA
I _D	漏极连续电流	A	-	-	5	T _j = 25 °C
R _{DS(on)}	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	1.15	1.40	V _{GS} = 10 V, I _D = 2.5 A
V _{GS(th)}	栅极门限电压	V	2.0	-	4.0	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA
I _{DSS}	漏极-源极 漏电流	μA	-	-	10	V _{DS} = 500 V, V _{GS} = 0 V
I _{GSS}	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V _{GS} = ± 30 V, V _{DS} = 0 V
T _j	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T _{STG}	储存温度范围	°C				